

性能特点：

- RF/LO 频段：18GHz~50GHz
- IF 频段：DC-18GHz
- 变频损耗：10dB
- RF-IF 隔离度：25dB
- LO-IF 隔离度：35dB
- LO-RF 隔离度：35dB
- 本振功率：13dBm
- 芯片尺寸：1.0mm×0.8mm×0.1mm

产品简介：

HH-MX1850M 是一种 GaAs MMIC 无源双平衡混频器，射频/本振频率分别覆盖 18-50GHz，中频频率覆盖 DC-18GHz，变频损耗小于 11dB，射频到中频隔离度大于 10dB，本振到中频隔离度大于 30dB，本振到射频隔离度大于 25dB，典型本振输入功率为 13dBm。

电参数： (TA=25°C,IF=1GHz,LO=13dBm)

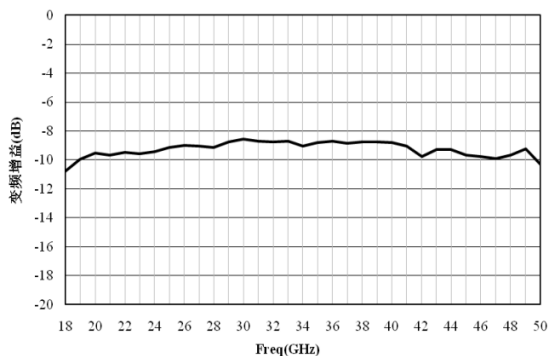
指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	18-50			GHz
本振频率	18-50			GHz
中频频率	DC-18			GHz
变频损耗	8.5	10	11	dB
RF-IF 隔离度	10	25	-	dB
LO-IF 隔离度	30	35	-	dB
LO-RF 隔离度	25	35	-	dB
P1dB(input)	-	12	-	dBm

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

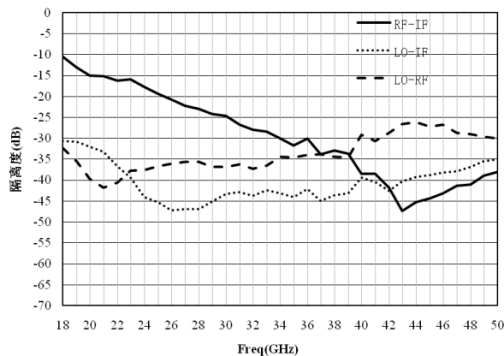
射频/中频功率	25dBm
本振功率	23dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-125°C

典型曲线：

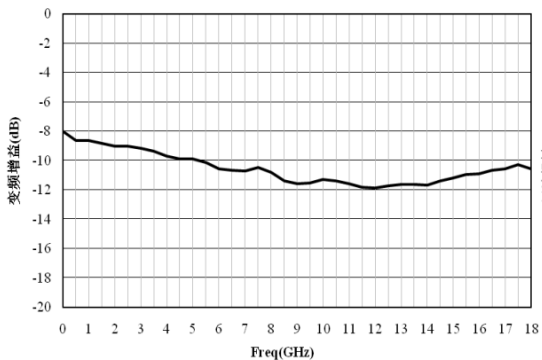
变频损耗曲线@LO=13dBm,中频频率 1GHz



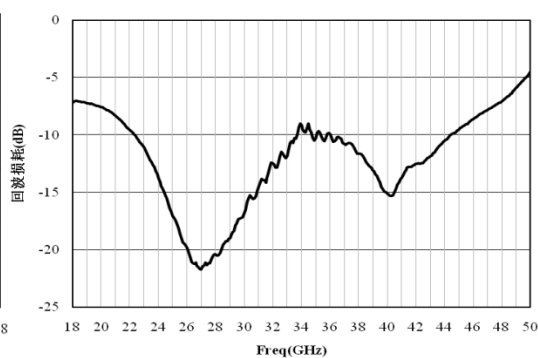
隔离度@LO=13dBm,中频频率 1GHz



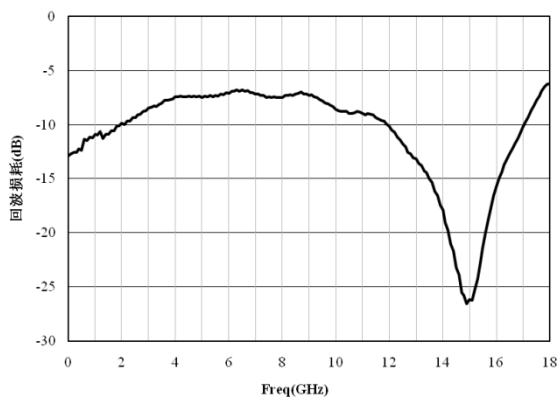
中频带宽@LO=40GHz,LO=13dBm



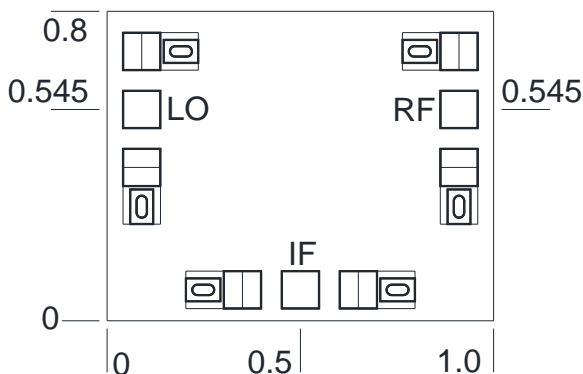
射频回波损耗



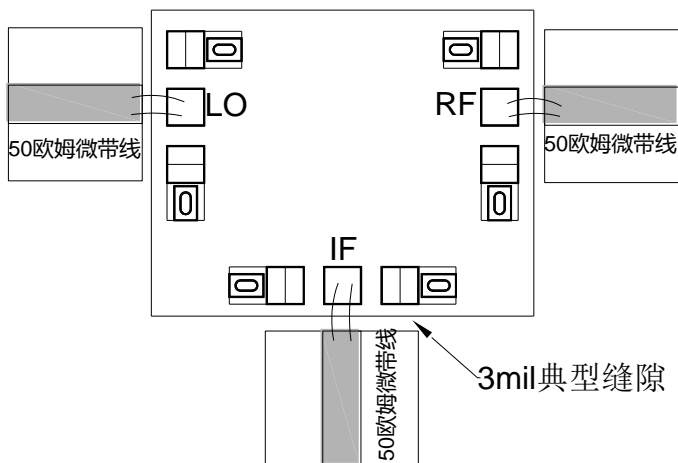
中频回波损耗



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。